¹³ Эмиссионные свойства сплава Pb–Ba, активированного лазерным облучением

© С.Б. Донаев, Б.Е. Умирзаков, Н.М. Мустафаева

Ташкентский государственный технический университет им. И.А. Каримова, 100095 Ташкент, Узбекистан e-mail: sardor.donaev@gmail.com

(Поступило в Редакцию 16 марта 2019 г. В окончательной редакции 16 марта 2019 г. Принято к публикации 13 апреля 2019 г.

> Проведен сравнительный анализ влияния температурной и лазерной активировки на значения коэффициента вторичной электронной эмиссии и работу выхода $e\varphi$ сплава Pd—Ba (Ba — 1.5 at.%). Показано, что оптимальная плотность энергии лазерного облучения равна $\sim 2 J \cdot cm^{-2}$. Определены основные причины уменьшения эмиссионной эффективности Pd—Ba при длительном прогреве.

> Ключевые слова: металлосплав, эмиссионные свойства, температурный отжиг, лазерная активировка, коэффициент вторичной электронной эмиссии, работа выхода, топография, эмиссионная эффективность.

DOI: 10.21883/JTF.2019.10.48183.95-19

Введение

В современных электровакуумных приборах СВЧ, в частности импульсных магнетронах, до сих пор успешно используются сплавные катоды типа Pd-Ba. Однако с переходом к наноразмерным слоям существенно увеличивались требования к размерам и микроструктуре поверхности, однородности состава, электрическим параметрам и сроку службы этих катодов [1,2]. Катод Pd-Ва представляет собой двухфазный сплав с массовой долей бария 0.5-2%, причем одна фаза — интерметаллическое соединение Pd2Ba или Pd5Ba, вторая тугоплавкий металл [1,3,4]. При использовании этих катодов выход годных магнетронов наивысший и составляет 75-80% и срок службы магнетронов не менее 5000 h. В отличие от других пленочных катодов в случае катодов из Pd-Ва ионная бомбардировка приводит к уменьшению работы выхода $e\phi$ на 0.3–0.4 eV [5]. После прекращения бомбардировки прежняя величина работы выхода восстанавливается. Вторично-эмиссионные свойства Pd-Ва под воздействием ионной бомбардировки также улучшаются.

Для применение сплавных катодов типа Pd-Ba в различных устройствах, например, в магнетронах, сначала (иногда периодический) проводится их активировка высокотемпературным прогревом до T = 800-1100 К в течение 3-5 h в условиях сверхвысокого вакуума или в атмосфере азота или водорода [6]. В связи с этим эти катоды изготавливаются в виде цилиндра, и внутри цилиндра размещается специальный узел нагрева. Для увеличения эмиссионной способности катода можно использовать метод низкоэнергетической ионной имплантации [7,8]. Основным преимуществом ионной имплантации является то, что этот метод можно использовать для катодов, вышедших из строя после

длительной эксплуатации. Однако и в этом случае после эксплуатации в течение 200-300 h необходимо будет проводить активировку при T = 700-800 К. Как проведение высокотемпературного прогрева, так и ионной бомбардировки катодов связаны с очень многими трудностями (громоздкость установки, большое потребление электроэнергии, необходимость герметизации узла нагрева и др.) и неконтролируемыми эффектами. Поэтому очень важно изыскание других методов активировки, например лазерной обработки. Влияние лазерной обработки на физические свойства ионно-легированных полупроводников Si и GaAs хорошо изучены в работах [9,10]. В частности, установлено, что при лазерном отжиге Si, имплантированного ионами Co⁺ и Ba⁺, образованы нанопленки типа CoSi2 и BaSi2. Однако подобные исследования для металлов и металлосплавов практический не проводились.

Настоящая работа посвящена сравнительному анализу эмиссионных свойств сплавов Pd-Ba (Ba — 1.5 at.%), активированных температурным прогревом и лазерной обработкой.

Методика эксперимента

Исследования проводились в многокамерном приборе с четырехсеточным квазисферическим анализатором в вакууме ~ $5 \cdot 10^{-7}$ Ра. Использовались поликристаллические образцы Pd–Ba с размерами $8 \times 8 \times 0.2$ mm. С помощью манипулятора мишень перемещалась по оси X и Y на 8–10 mm. Температурный отжиг осуществлялся с тыльной стороны образца нагревом вольфрамовой спирали (до T = 800-900 K) или электронной бомбардировкой (до T = 2000 K). Лазерный отжиг проводился с помощью твердотельного (Nd³⁺) импульсного лазера, имеющего следующие параметры: длина волны

1.06 и 0.53 µm (вторая гармоника), длительность импульсов на полувысоте 10-50 ns, плотность энергии W импульса на поверхности образца $0.1-0.3 \, \mathrm{J} \cdot \mathrm{cm}^{-2}$, частота повторения импульсов 1-50 Hz, нестабильность энергий импульса 3-5%. Лазерные лучи с диаметром 2-2.5 mm направлялись на поверхность мишени через кварцевое окошко. Изменяя положения мишени, можно было активировать всю поверхность сплава Pd-Ba. Исследования проводились с использованием методов: оже-электронной спектроскопии (ОЭС), растровой электронной микроскопии (РЭМ), ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии (УФЭС) и снятием зависимостей коэффициентов вторичной электронной эмиссии (КВЭЭ). Значение еф определялось методом контактной разности потенциалов, т.е. по изменению положения начальной части спектра фотоэлектронов исследуемого образца, относительно спектра чистого Pd [11].

Результаты и обсуждение

На рис. 1 представлена динамика изменения максимального значения КВЭЭ σ_m и значении работы выхода $e\varphi$ сплава Pd-Ва при активировке температурным прогревом и лазерным облучением. Анализ результатов ОЭС, снятых после каждого цикла обработки, показал, что как в процессе термической, так и лазерной обработки наряду с очисткой поверхности от загрязнений происходит диффузия атомов Ва к поверхности, вследствие чего изменяется состав и соответственно эмиссионные свойства поверхности Pd-Ва. Из рис. 1 видно, что в случае прогрева при относительно низких температурах ($T \leq 600$ K), когда на поверхности Pd-Ва содержится значительное количество примесных атомов, а диффузия Ва к поверхности еще мала, вторично-эмиссионные характеристики поверхности меняются незначительно.



Рис. 1. Зависимости значении σ_m , $e\varphi$ от температуры прогрева (1, 2) и плотности энергии лазерного облучения (3) для сплава Pd—Ba: $I, 3 - \sigma_m, 2 - e\varphi$.



Рис. 2. РЭМ-изображение поверхности Pd-Ba, снятое после эксплуатации в течение более 500 h.

Высокотемпературный прогрев ($T \ge 1000 \text{ K}$) приводит к резкому снижению концентрации примесных атомов и увеличению в поверхностных слоях относительной концентрации атомов Ва, что способствует существенному увеличению σ_m и уменьшению $e\varphi$.

Наибольшее изменение параметров имеет место в интервале температур $T \simeq 1050 - 1150$ К. При этом интенсивность оже-пиков характерных примесных атомов уменьшается до минимума (см. таблицу). Начиная с T = 1200 К, наблюдается интенсивная десорбция бария с поверхности.

В случае лазерного облучения увеличение σ_m (уменьшение $e\phi$) начинается с плотности энергии $W \approx 0.8 - 1.0 \,\mathrm{J} \cdot \mathrm{cm}^{-2}$ и при $W \approx 2.0 - 2.2 \,\mathrm{J} \cdot \mathrm{cm}^{-2}$ достигает своего максимального значения и составляет ~ 3.5 , что значительно больше, чем в температурном прогреве. При лазерной активировке оптимальным являлся плотность энергии (см. таблицу).

При активировке в высоком вакууме концентрация Ва на поверхности увеличивается до 40-42 at.%, а концентрация примесных атомов О, С, S составляет 10, 2, 1 at.% соответственно. При активировке в атмосфере N2 и H2 поверхностная концентрация Ва составляет 42-45 at.%, а концентрации О, С, S — уменьшаются. Это приводит к существенному увеличению σ_m . Активировка сплава Pd-Ва в среде H₂ приводит к более интенсивному удалению примесных атомов при низких температурах, чем прогрев в высоком вакууме. Эти результаты хорошо согласуются с данными, полученными ранее авторами работ [2,6]. Лазерная активировка позволяет интенсивно удалить атомы примесных элементов и увеличить σ_m до 3.5 без напуска водорода (см. таблицу). Измерение профилей распределения атомов Ва по глубине показали, что высокая концентрация Ва содержится только на поверхности с толщиной d = 3-4 Å, в интервале d = 5-15 Å, концентрация Ва составляет ~ 30 at.% и в этих слоях формируется сплав типа Pd₂Ba.

Условия активировки	$W, J \cdot cm^{-2}$	T _{opt.} , K	Концентрация атомов в at.%					σ_m	<i>eø</i> . eV
			Ba	Pd	0	С	S	- 11	
В высоком вакууме	_	1100	41	46	10	2	1	2.5	2.5
В атмосфере N ₂	—	1000	42	49	8	1	_	2.9	2.2
В атмосфере Н ₂	—	1000	45	51	4	—	—	3.6	2.2
В высоком вакууме	2	—	44	51	4	—	—	3.5	2.2

Влияние условий активировки на эмиссионные свойства PdBa

Отметим, что активировка Pd–Ва в среде кислорода в определенных условиях (при образование монослойного покрытия типа Ba₂O или BaO) приводит к существенному уменьшению работы выхода $e\varphi$ [2,8]. Из таблицы видно, что при активировке Pd–Ba в условиях высокого вакуума (хотя поверхностная концентрация O₂ составляет ~ 10 at.%) максимального уменьшения $e\varphi$ не наблюдается. Это объясняется тем, что при наличие примесных атомов O, C, S концентрация Ba на поверхности будет меньше одного монослоя. Кроме того, результаты OЭC показали, что после активировки на поверхности образуется некоторое количества соединении типа C + O, S + O. Только при полном удалении C и S происходит существенное уменьшение е φ .

Известно, что в процессе эксплуатации катодов эмиссионные параметры могут меняться из-за адсорбции атомов остаточных газов на поверхности, длительного прогрева и бомбардировки ее заряженными частицами (электронами, ионами, остаточного газа). Простая выдержка Pd–Ba, активированного лазерным облучением, в вакууме ~ 10^{-5} Pa в течение 5–6 h приводила к уменьшению σ_m до ~ 2.7 и появлению на поверхности атомов углерода до ~ 1-1.5 at.% и увеличению концентрации кислорода до 7–8 at.%. Затем в течение 100 и более часов состояние поверхности практически не изменялось. В случае длительного прогрева этого же образца Pd–Ba при $T \approx 700-750$ K значения σ_m и $e\varphi$ заметно не изменялись в течение 500–550 h.

Дальнейшее увеличение времени прогрева приводило к монотонному уменьшению σ_m и при $t \ge 600$ h значение σ_m стабилизировалось на уровне 1.9–2.

Повторная лазерная активировка этого же катода при $T \approx 1050$ К не приводила к заметному увеличению σ_m . Для выяснения причины ухудшения эмиссионной эффективности нами снимались РЭМ-изображения поверхности Pd—Ba, подвергнутой прогревом в течение ~ 600 h.

Из рис. 2 видно, что на гладкой поверхности Pd-Ва имеются отдельные дефектные участки с диаметрами $10-15\,\mu$ m. Дальнейшие исследования показали, что глубина этих участков достигает $20-30\,\mu$ m. По-видимому, износ катодов на основе Pd-Ва обусловлен появлением на его поверхности дефектных участков в виде пузырьков. Результаты ОЭС показали, что в этих участках содержится значительное количество атомов С

 $(\sim 11 \text{ at.}\%)$, S (2.5 at.%), O (13 at.%). Увеличение концентрации примесных атомов в дефектных участках могут быть обусловлены диффузией O, C и S из объема Pd—Ba.

Заключение

Сравнительный анализ показал, что в условиях высокого вакуума лазерная активировка приводит к значительно большому увеличении σ_m , чем в случае температурной активировки. Это объясняется интенсивным удалением примесных атомов О, С, S под действием лазерных лучей. Определены оптимальные режимы лазерной активировки. Показано, что активированные сплавы Pd—Ва выдерживают значительные температурные нагрузки ($T \approx 700$ K) в течение 450–500 h. Дальнейшее увеличение времени прогрева приводит к появлению дефектных участков, обогащенных атомами О, С и S.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- [1] Дюбуа Б.Ч., Королёв А.Н. // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ-техника. Вып. 1 (508). 2011. С. 5–24.
- [2] Дюбуа Б.Ч., Култашев О.К., Поливникова О.В. // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ-техника. Вып. 4 (497). 2008. С. 3–21.
- [3] Ли И.П., Леденцова Н.Е., Поляков В.С., Силаев А.Д., Каширина Н.В., Калушин С.В., Комиссарчик С.В., Лифанов Н.Д. // Наукоемкие технологии. 2014. № 11. С. 32–38.
- [4] Дмитриева В.Н., Есаулов Н.П., Журавлев Н.Н., Рождественский В.М. // Благородные металлы и их применение: сб. Свердловск. 1971. Вып. 28. С. 58.
- [5] Гнучев Н.М., Каничева И.Р., Кирсанова Т.С. // Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. 1970. Вып. 12. С. 131.
- [6] Дюбуа Б.Ч., Сытник А.Я. // Электронная техника. Сер. 1. Электроника СВЧ. 1976. Вып. 6. С. 68.
- [7] Умирзаков Б.Е., Мирзаев Д.А., Нормуродов М.Т. // Поверхность. Физика, химия, механика. 1991. Вып. 9. С. 25–32.
- [8] Умирзаков Б.Е. Донаев С.Б. // Электронная техника. Сер. 1. СВЧ-техника. 2014. Вып. 2 (521). С. 65–72.

- [9] Мурадкабилов Д.М., Таимухамедова Д.А., Умирзаков Б.Е. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2013. № 10. С. 58–62. [Мигадкаbilov D.M., Tashmukhamedova D.A., Umirzakov B.E. // J. Surf. Investigation. 2013. Vol. 7. N 5. Р. 967–971.]
- [10] Умирзаков Б.Е., Ташмухамедова Д.А., Рузибаева М.К., Ташатов А.К., Донаев С.Б., Мавлянов Б.Б. // ЖТФ. 2013. Т. 83. Вып. 9. С. 146–149. [Umirzakov B.E., Tashmukhamedova D.A., Ruzibaeva M.K., Tashatov A.K., Donaev S.B., Mavlyanov B.B. // Tech. Phys. 2013. Vol. 58. N 9. P. 1383–1386.]
- [11] Умирзаков Б.Е., Нормуродов М.Т., Раббимов Э.А. // Известия РАН. Сер. физическая. 1992. Т. 56. № 7. С. 48–53.